

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

2. 5. Модули на частотных диодах *

Представляют собой комбинации схем включения частотных диодов (МДЧДЧ) следующих типов исполнения:

МДЧДЧ4/3-25,
МДЧДЧ4/3-40,
МДЧДЧ4/3-50,
МДЧДЧ4/3-63,
МДЧДЧ4/3-80;

МДЧДЧ4/4-25,
МДЧДЧ4/4-40,
МДЧДЧ4/4-50,
МДЧДЧ4/4-63,
МДЧДЧ4/4-80;

МДЧДЧ4/5-25,
МДЧДЧ4/5-40,
МДЧДЧ4/5-50,
МДЧДЧ4/5-63,
МДЧДЧ4/5-80.

Предназначены для работы в устройствах с высокочастотной коммутацией электрических цепей.

Используются в системах высокочастотного преобразования электрической энергии.

Схемы соединения элементов указанных типов исполнения модулей на частотных диодах приведены на рис. 2. 107.

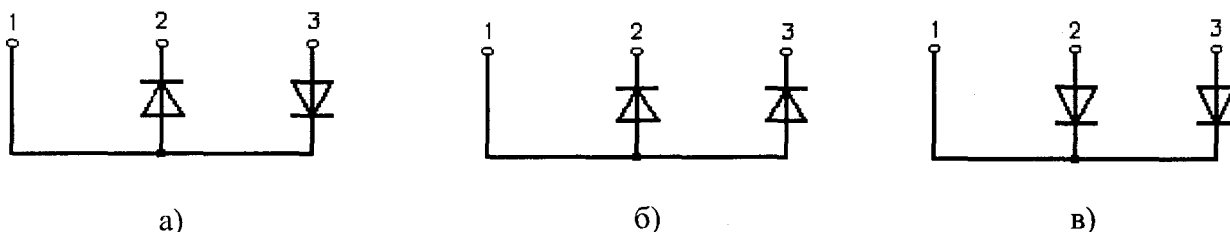


Рис. 2. 107. Схемы соединения полупроводниковых элементов модулей на частотных диодах:

а) МДЧДЧ4/3-25, МДЧДЧ4/3-40, МДЧДЧ4/3-50, МДЧДЧ4/3-63, МДЧДЧ4/3-80

б) МДЧДЧ4/4-25, МДЧДЧ4/4-40, МДЧДЧ4/4-50, МДЧДЧ4/4-63, МДЧДЧ4/4-80;

в) МДЧДЧ4/5-25, МДЧДЧ4/5-40, МДЧДЧ4/5-50, МДЧДЧ4/5-63, МДЧДЧ4/5-80.

Предельно допустимые значения параметров модулей на частотных диодах приведены в табл. 2. 17, их параметры и характеристики - табл. 2. 18, параметры и характеристики модулей с охладителями - табл. 2. 19 и 2. 20.

* **Изменение в каталоге:** в связи со снятием с производства рекомендуемых охладителей заменить О127 на ОР344-120, О227 на ОР344-180 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004 (Габаритные чертежи на www.element.zp.ua в Списке продукции/Охладители). При этом все тепловые расчеты и характеристики сохраняются.

Таблица 2. 17.

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры	
Обозначение	Наименование, единица измерения	Тип модуля						
		МДЧДЧ4-25	МДЧДЧ4-40	МДЧДЧ4-50	МДЧДЧ4-63	МДЧДЧ4-80		
1	2	3	4	5	6	7	8	
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14			400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400				$T_{jm}=125\text{ }^{\circ}\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

Продолжение табл. 2. 17.

1	2	3	4	5	6	7	8
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В	1,12 U_{RRM}					$T_{jm} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
U_{RWM}	Рабочее импульсное обратное напряжение, В	0,8 U_{RRM}					$T_{jm} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
U_R	Постоянное обратное напряжение, В	0,6 U_{RRM}					$T_c = 85 \text{ }^\circ\text{C}$.
$I_{F(AV)}$	Максимально допустимый средний прямой ток, А	25	40	50	63	80	$T_c = 85 \text{ }^\circ\text{C}$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
I_{FRMS}	Действующий прямой ток, А	39	63	78	100	125	Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
I_{FSM}	Ударный прямой ток, кА	0,44	0,55	1,1	1,3	1,65	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, $U_R = 0$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс.
		0,40	0,50	1,00	1,20	1,50	$T_{jm} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$, $U_R = 0$. $I_G = I_{GT}$ при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс.
U_{isol}	Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием модуля и его выводами (действующее значение), В	2000 (для 4-8 кл.) 2500 (для 9-14 кл.)					Напряжение синусоидальное, частота 50 Г. Время выдержки под напряжением - 60 с. Выводы 1,2,3 закорочены между собой.
T_{jm}	Температура перехода, $^\circ\text{C}$: максимально допустимое значение;	125					—
T_{jmin}	минимально допустимое значение.	минус 40					—

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

Продолжение табл. 2. 17

1	2	3	4	5	6	7	8	
T_{stgm}	Температура хранения, °С: максимально допустимое значение,	40 (для У2), 50 (для Т3)						
T_{stgmin}	минимально допустимое значение	минус 40						

Таблица 2. 18.

Характеристики и параметры модулей на частотных диодах

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры	
Обозначение	Наименование, единица измерения	Тип модуля						
		МДЧДЧ4-25	МДЧДЧ4-40	МДЧДЧ4-50	МДЧДЧ4-63	МДЧДЧ4-80		
1	2	3	4	5	6	7	8	
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение, В, не более	2,0					$T_j = 25\text{ °C};$ $I_{FM} = 3,14 I_{F(AV)}$	
U_{TO}	Пороговое напряжение, В	1,2			1,1		$T_j = 125\text{ °C}.$	
r_T	Динамическое сопротивление, Ом	0,0100	0,0064	0,0050	0,0045	0,0036	$T_j = 125\text{ °C}.$	
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	12			15		$T_j = 125\text{ °C};$ $U_R = U_{RRM}.$	
t_{rr}	Время обратного восстановления, мкс, не более, для группы:						$T_j = 125\text{ °C};$ $\left(\frac{di}{dt}\right)_r = 5\text{ А/мкс};$ $I_{FM} = I_{F(AV)};$ $T_u \geq 200\text{ мкс};$ $U_R = 100\text{ В}.$	
		А5	Х4	Т4	Р4	М4	К4	
		1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,20	
		—	—	—	—	—	—	
		—	1,60	2,00	2,50	3,20		
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход - корпус, на элемент, °С/Вт	0,5	0,4	0,3	0,28	0,26	Постоянный ток.	

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

Таблица 2.19.

Характеристики и параметры модулей на частотных диодах с охладителем O127 *

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры
Обозначение	Наименование, единица измерения	Тип модуля					
		МДЧД4-25	МДЧД4-40	МДЧД4-50	МДЧД4-63	МДЧД4-80	
		Тип охладителя					
O127							
1	2	3	4	5	6	7	8
$I_{F(AV)}$	Средний прямой ток на элемент, А	25	36	41	45	48	Естественное охлаждение $T_a = 40$ °С. Ток синусоидальный, однополупериодный. Частота 50 Гц. В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.
		22	25	27	29	31	
		14	15	16	18	18,5	
		10	11	12	13	13,5	
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, °С/Вт	1,40	1,30	1,20	1,18	1,16	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.
		2,20	2,10	2,00	1,98	1,96	
		3,80	3,70	3,60	3,58	3,56	
		5,40	5,30	5,20	5,18	5,16	
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус - контактная поверхность охладителя, °С/Вт	0,1					Естественное охлаждение. Постоянный ток.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

Таблица 2. 20.

Характеристики и параметры модулей на частотных диодах с охладителем O227*

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры
Обозна- чение	Наименование, единица измерения	Тип модуля					
		МДЧДЧ 4-25	МДЧДЧ 4-40	МДЧДЧ 4-50	МДЧДЧ 4-63	МДЧДЧ 4-80	
		Тип охладителя					
O227							
1	2	3	4	5	6	7	8
$I_{F(AV)}$	Средний прямой ток на элемент, А	25	39	45	49	53	Естественное охлаждение. $T_a = 40^\circ\text{C}$. Ток синусоидальный, однополупериодный Частота 50 Гц. В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.
		24	28	31	33	35	
		16	18	19	21	21,5	
		12	13	14	15	15,5	
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$.	1,26	1,16	1,06	1,04	1,02	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.
		1,92	1,82	1,72	1,70	1,68	
		3,24	3,14	3,04	3,02	3,00	
		4,56	4,46	4,36	4,3	4,32	
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус - контактная поверхность охладителя, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0,1					Естественное охлаждение. Постоянный ток.

Вольтамперные характеристики СПМ на частотных диодах в открытом состоянии приведены на рис. 2. 108. Зависимости допустимого среднего тока в открытом состоянии от температуры корпуса показаны на рис. 2. 109 и 2. 110. Зависимости допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии от его длительности приведены на рис. 2. 111. Зависимости средней рассеиваемой мощности от тока в открытом состоянии при различных углах проводимости показаны на рис. 2. 112 и 2. 113.

Зависимость времени обратного восстановления от скорости спада прямого тока модуля приведена на рис. 2. 114, влияние прямого тока на время обратного восстановления - на рис. 2. 115, влияние температуры на время обратного восстановления - на рис. 2. 116. Зависимость заряда обратного восстановления от скорости спада прямого тока модуля показана на рис. 2. 117. Зависимость заряда обратного восстановления от прямого тока приведена на рис. 2. 118. Зависимость заряда обратного восстановления от температуры приведена на рис. 2. 119. Зависимости допустимого среднего тока модулей при различных условиях от температуры окружающей среды приведены на рис. 2. 120, 2. 121. Зависимости переходных тепловых сопротивлений показаны на рис. 2. 122. Типичная зависимость допустимого среднего прямого тока от частоты показана на рис. 2. 123. Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока модулей при различных условиях охлаждения приведены на рис. 2. 124 - 2. 136.*

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

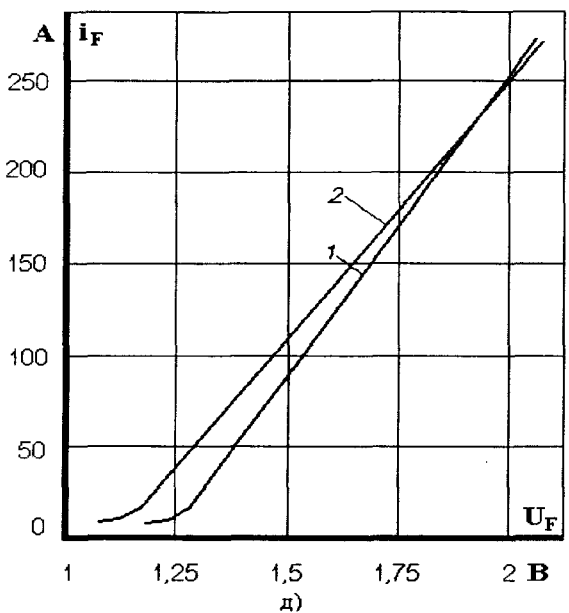
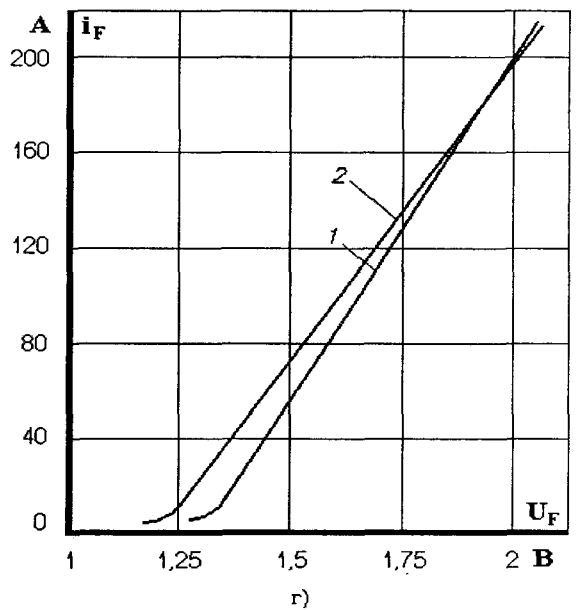
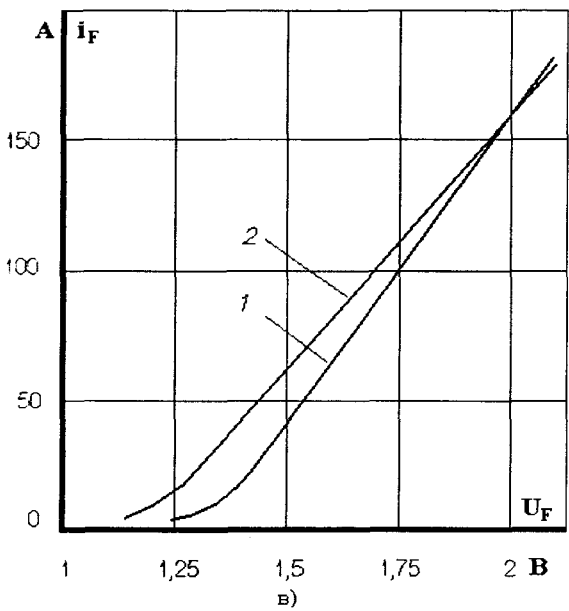
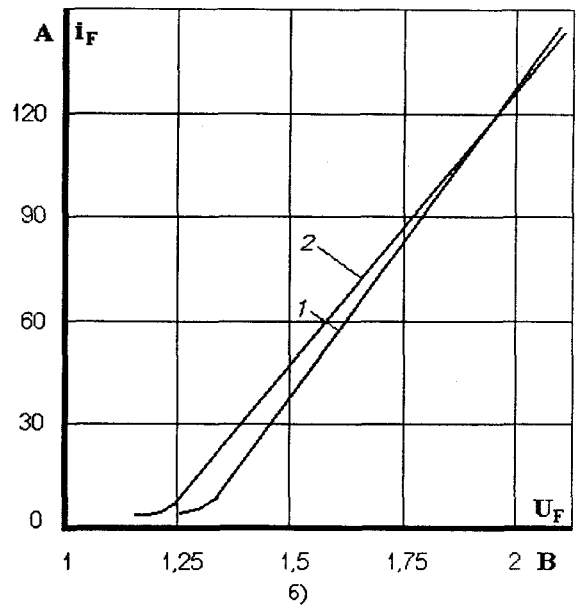
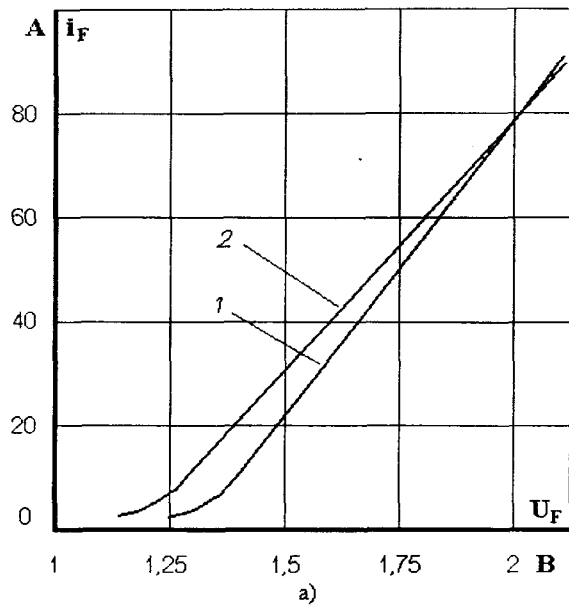
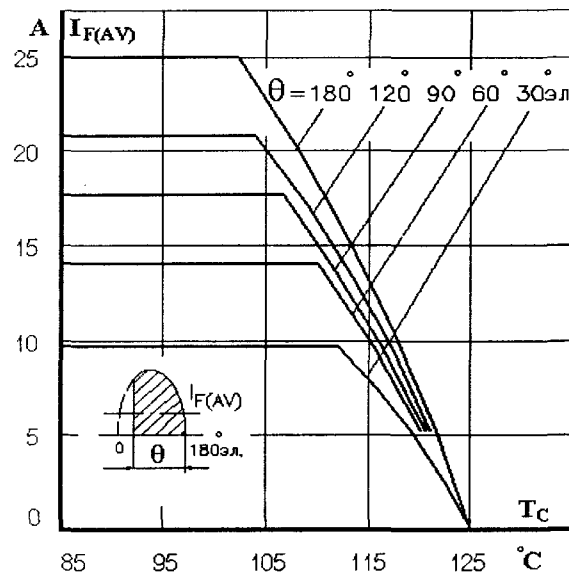


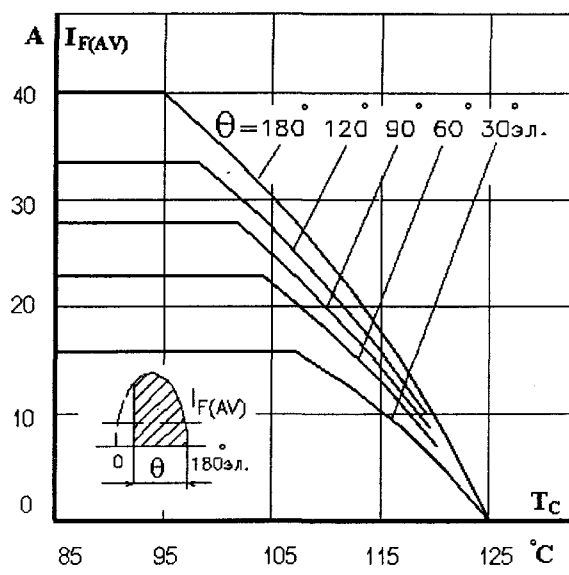
Рис. 2. 108. Предельные прямые вольтамперные характеристики при температуре перехода $T_j = 25\text{ °C}$ (1) и максимальной температуре перехода $T_{jm} = 125\text{ °C}$ (2):

- а) МДЧД4-25; б) МДЧД4-40;
- в) МДЧД4-50; г) МДЧД4-63;
- д) МДЧД4-80.

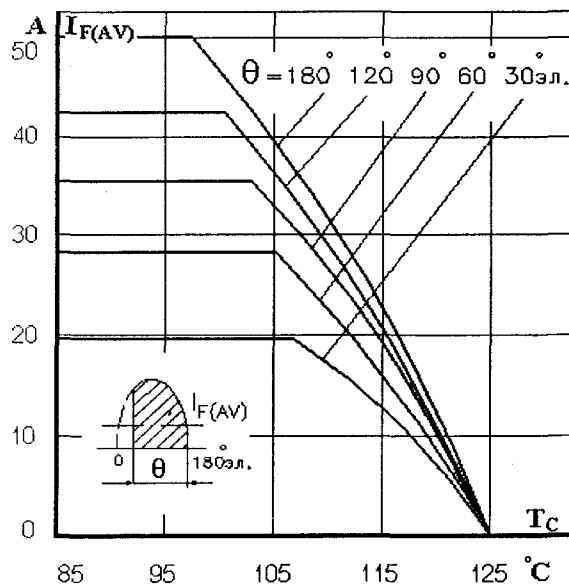
МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ



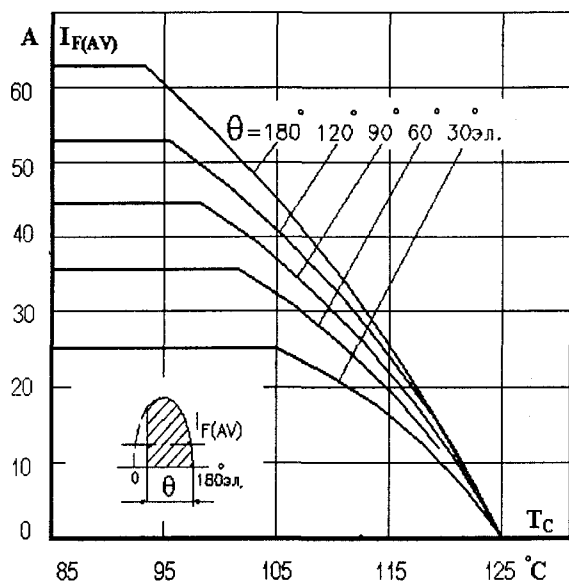
а)



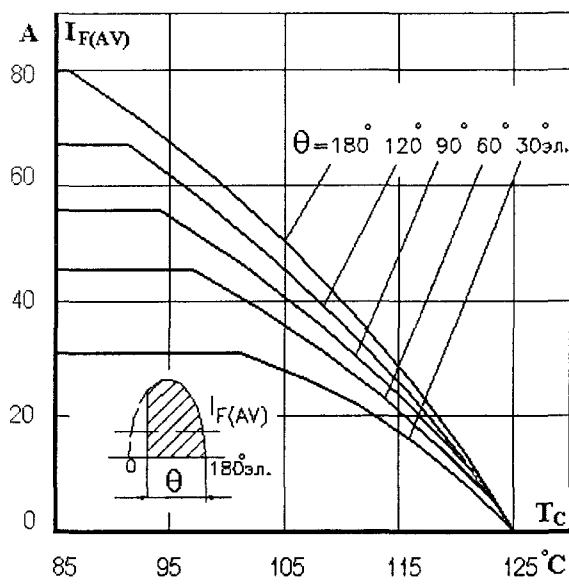
б)



в)



г)



д)

Рис. 2. 109. Зависимости допустимого среднего прямого тока синусоидальной формы $I_{F(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры корпуса T_C при различных углах проводимости:

- а) МДЧД4-25; б) МДЧД4-40;
- в) МДЧД4-50; г) МДЧД4-63;
- д) МДЧД4-80.

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

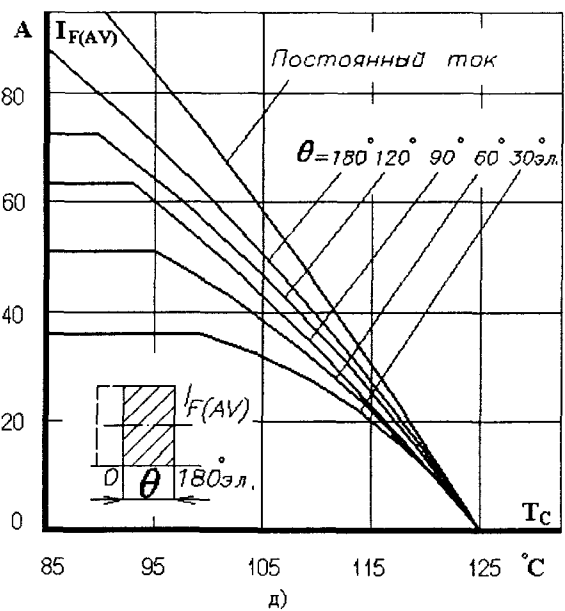
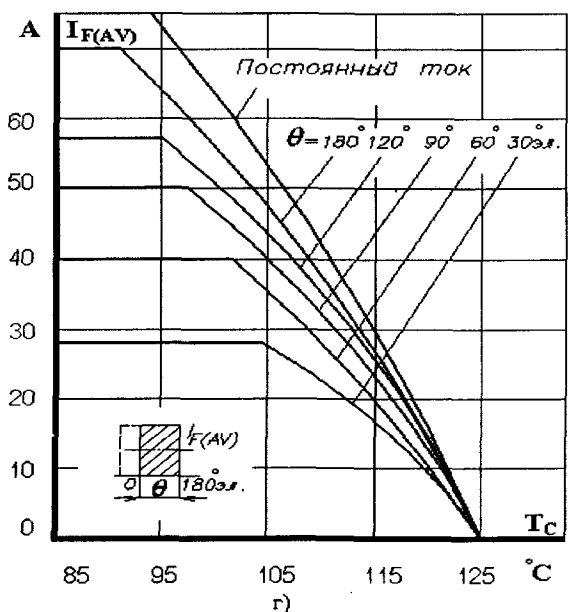
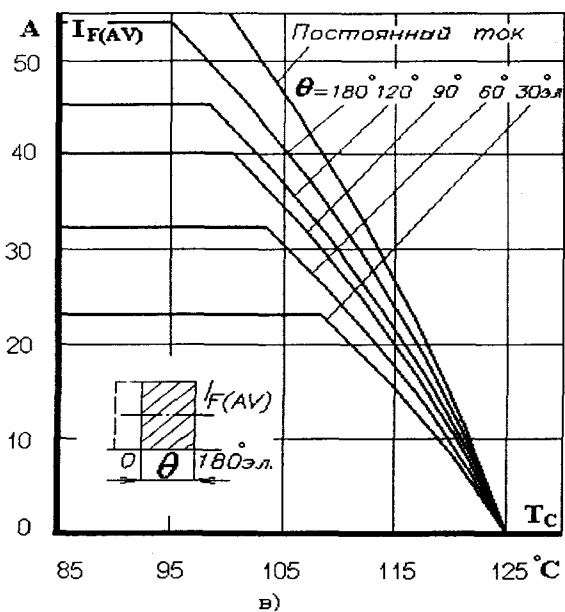
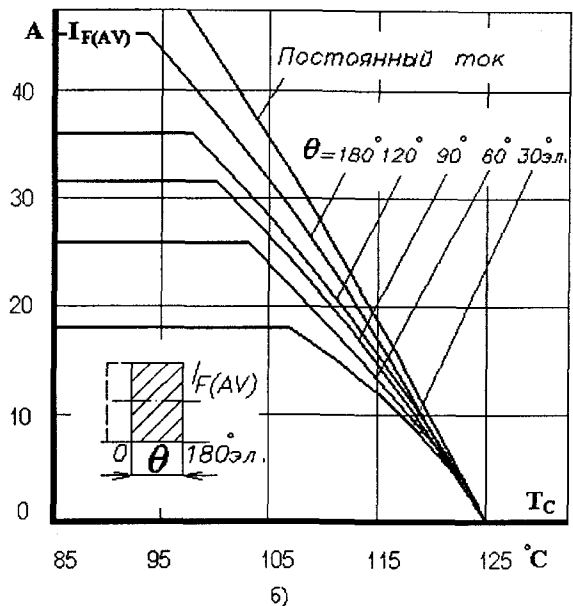
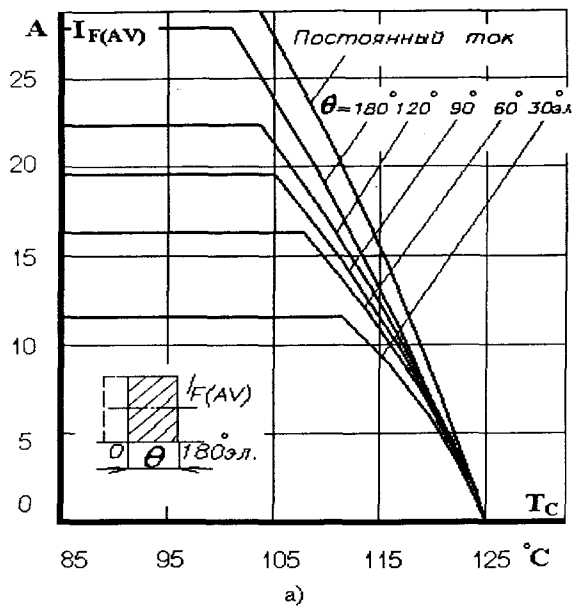


Рис. 2. 110. Зависимости допустимого среднего прямого тока прямоугольной формы $I_{F(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры корпуса T_c при различных углах проводимости:

- а) МДЧДЧ4-25; б) МДЧДЧ4-40;
- в) МДЧДЧ4-50; г) МДЧДЧ4-63;
- д) МДЧДЧ4-80.

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

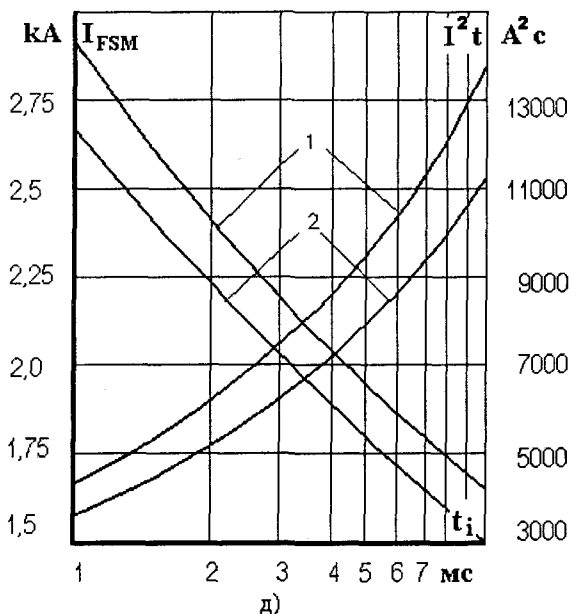
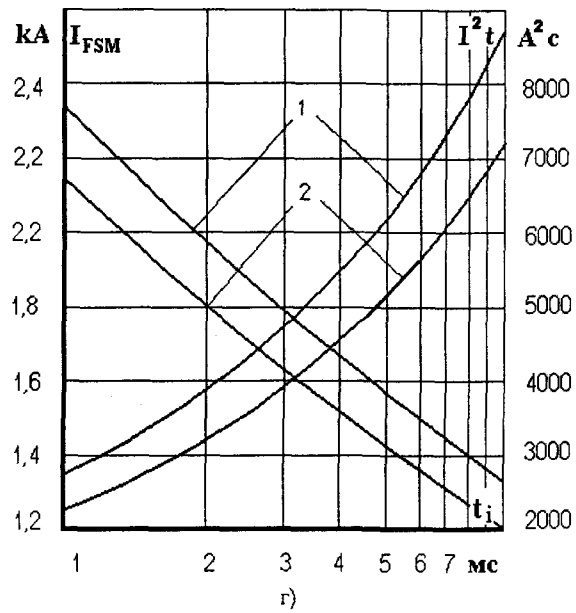
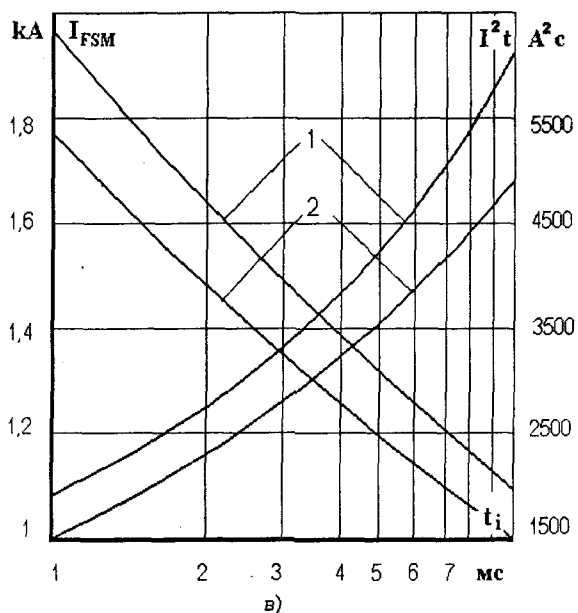
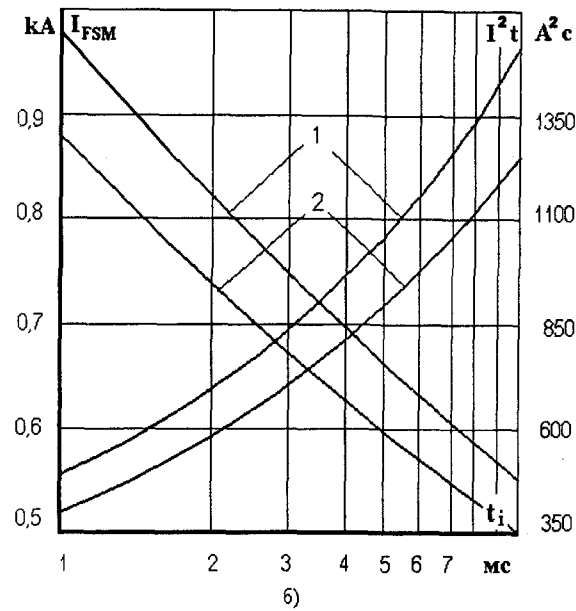
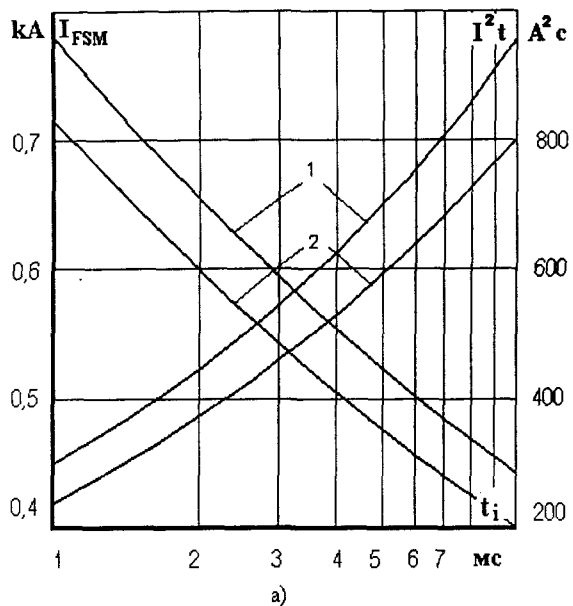


Рис. 2. 111. Зависимости допустимой амплитуды ударного прямого тока I_{FSM} и защитного показателя I^2t от длительности импульса тока t_i при температуре перехода $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ (1) и максимальной температуре перехода $T_{jm} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ (2):

- а)МДЧДЧ4-25; б)МДЧДЧ4-40;
- в)МДЧДЧ4-50; г)МДЧДЧ4-63;
- д)МДЧДЧ4-80.

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

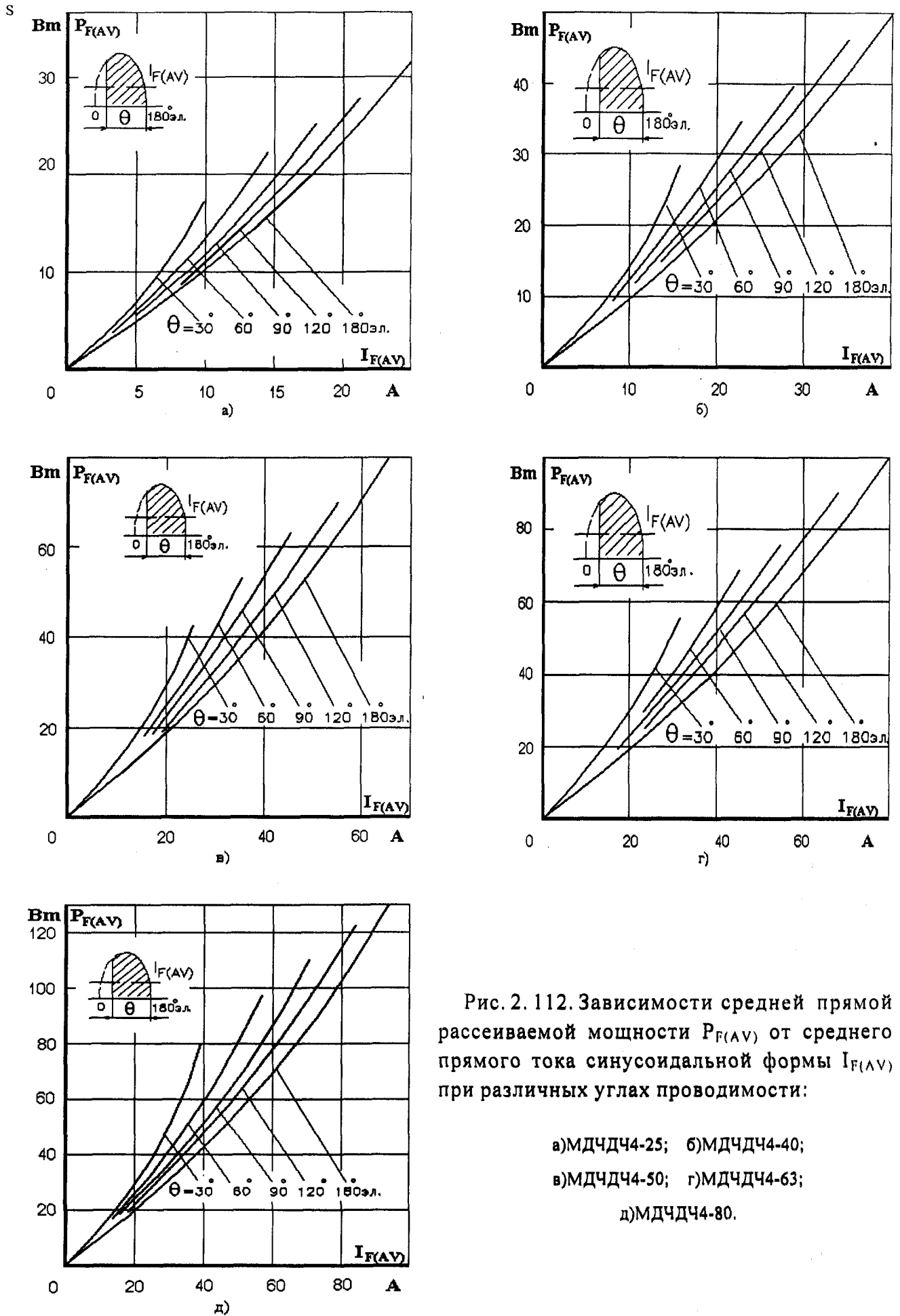


Рис. 2.112. Зависимости средней прямой рассеиваемой мощности $P_{F(AV)}$ от среднего прямого тока синусоидальной формы $I_{F(AV)}$ при различных углах проводимости:

- а) МДЧД4-25; б) МДЧД4-40;
- в) МДЧД4-50; г) МДЧД4-63;
- д) МДЧД4-80.

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

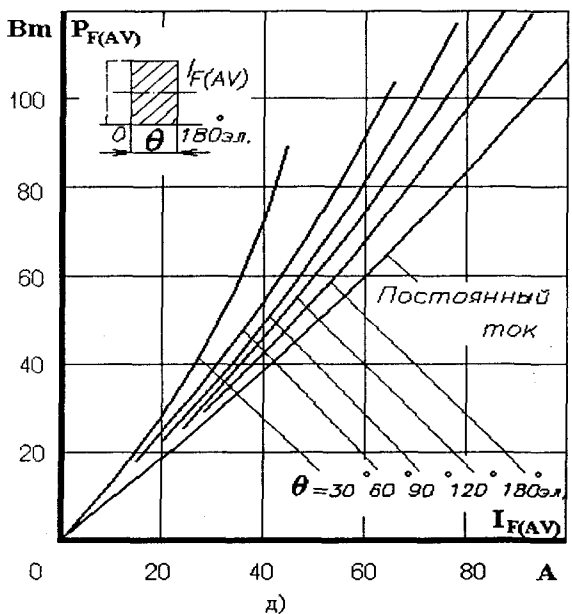
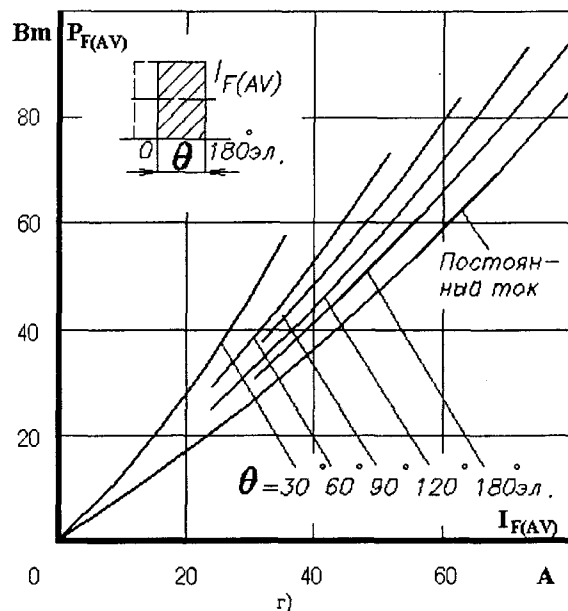
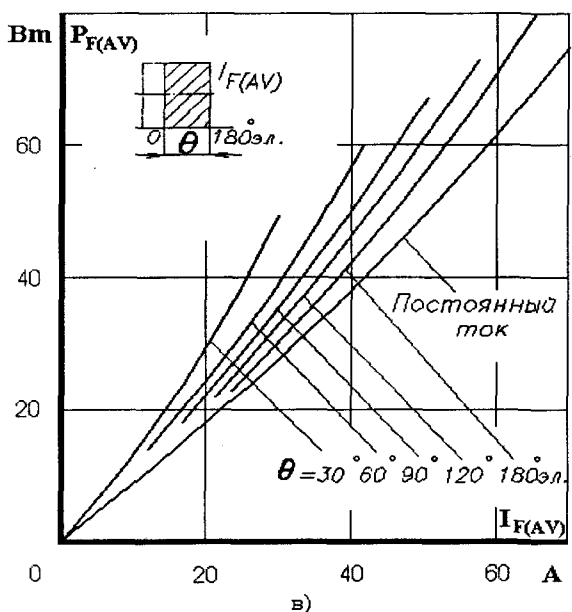
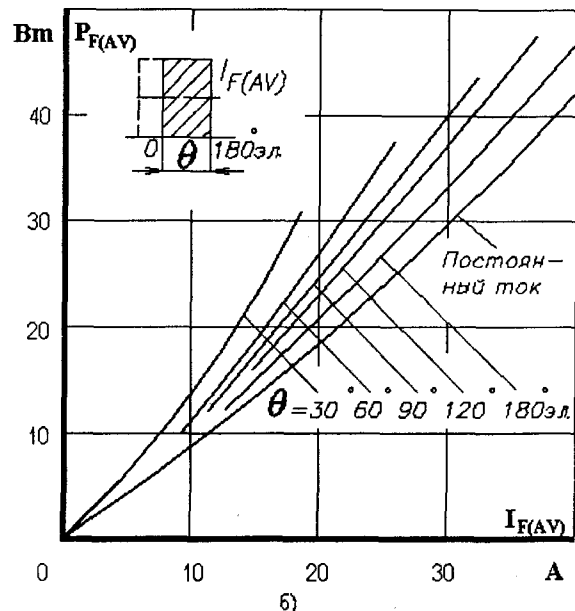
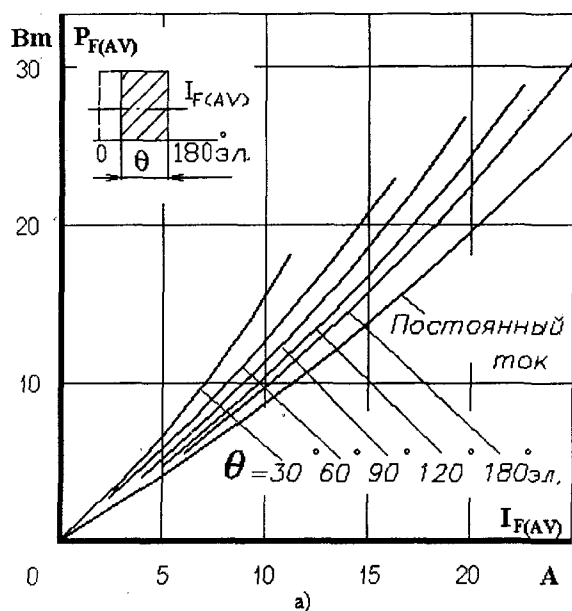


Рис. 2. 113. Зависимости средней прямой рассеиваемой мощности $P_{F(AV)}$ от среднего прямого тока прямоугольной формы $I_{F(AV)}$ при различных углах проводимости:

- а) МДЧДЧ4-25; б) МДЧДЧ4-40;
- в) МДЧДЧ4-50; г) МДЧДЧ4-63;
- д) МДЧДЧ4-80.

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

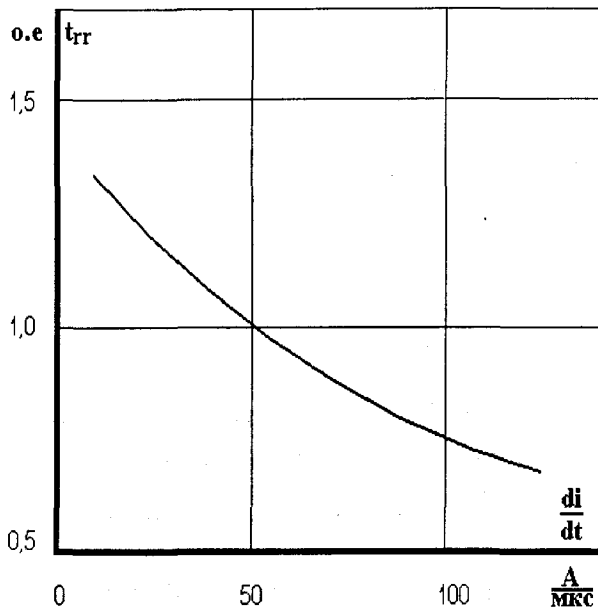


Рис. 2. 114. Зависимость времени обратного восстановления t_{rr} от скорости спада прямого тока $\left(\frac{di}{dt}\right)_f$ при максимальной температуре перехода T_{jm} , $U_R = 100$ В и предшествующем прямом токе $I_{FM} = I_{F(AV)}$

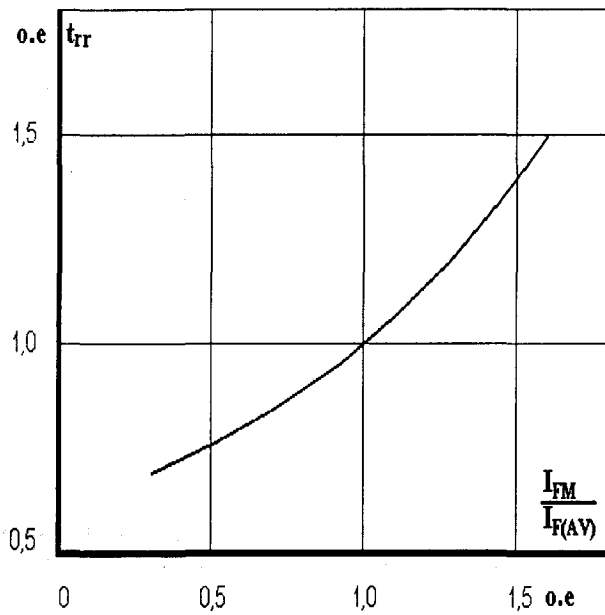


Рис. 2. 115. Зависимость времени обратного восстановления t_{rr} от прямого тока $I_{FM}/I_{F(AV)}$ при $T_j = 25$ °С

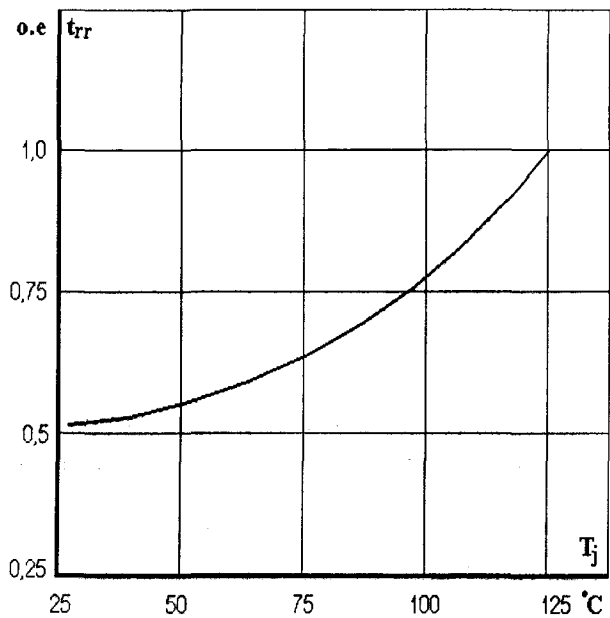


Рис. 2. 116. Зависимость времени обратного восстановления t_{rr} от температуры T_j при $I_{FM} = I_{F(AV)}$, $\left(\frac{di}{dt}\right)_f = 5$ А/мкс

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

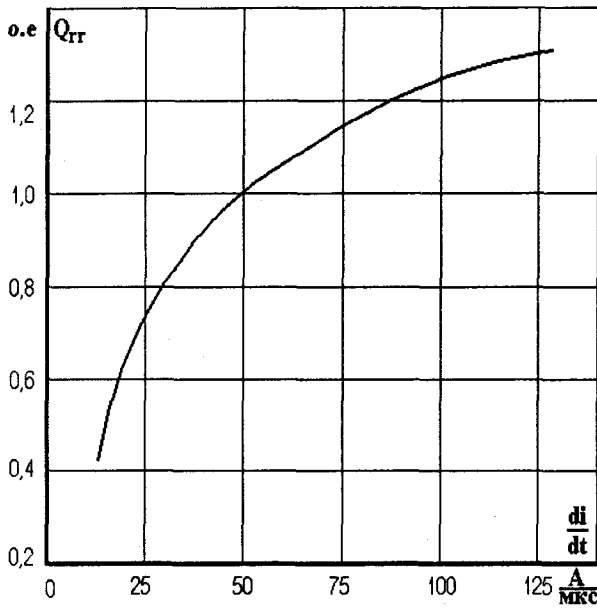


Рис. 2. 117. Зависимость заряда обратного восстановления Q_{rr} от скорости спада прямого тока $\left(\frac{di}{dt}\right) f$ при максимальной температуре перехода $T_{jm} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$, $U_R = 100 \text{ В}$, $I_{FM} = I_{F(AV)}$

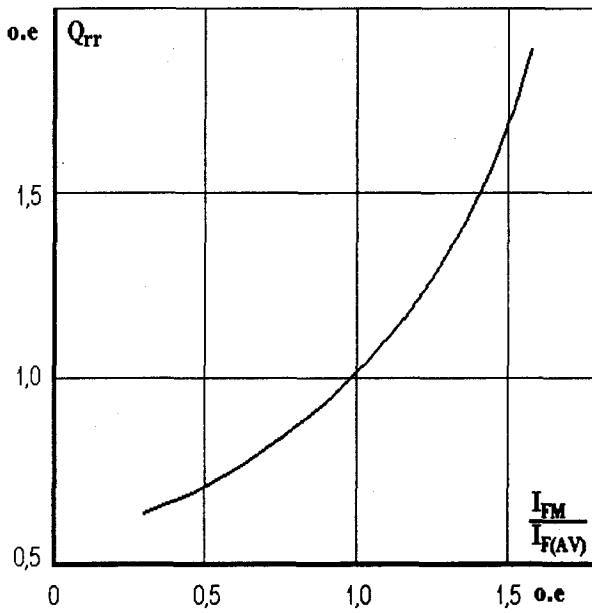


Рис. 2. 118. Зависимость заряда обратного восстановления Q_{rr} от прямого тока $I_{FM} / I_{F(AV)}$, $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

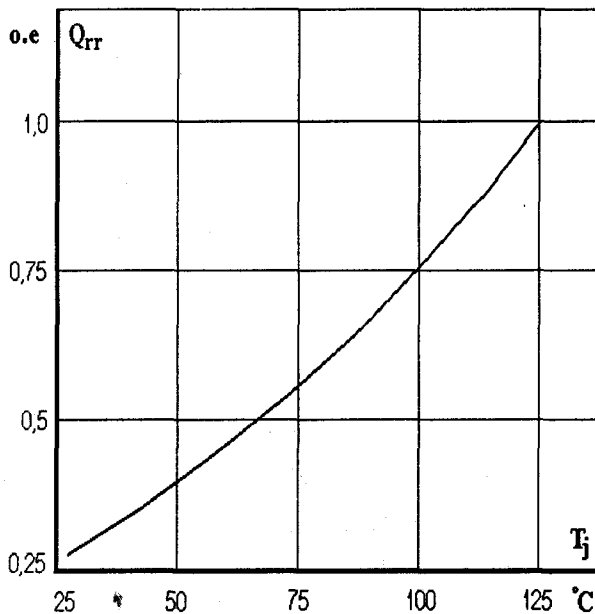


Рис. 2. 119. Зависимость заряда обратного восстановления Q_{rr} от температуры T_j при $I_{FM} = I_{F(AV)}$, $\left(\frac{di}{dt}\right) f = 50 \text{ А/мкс}$

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

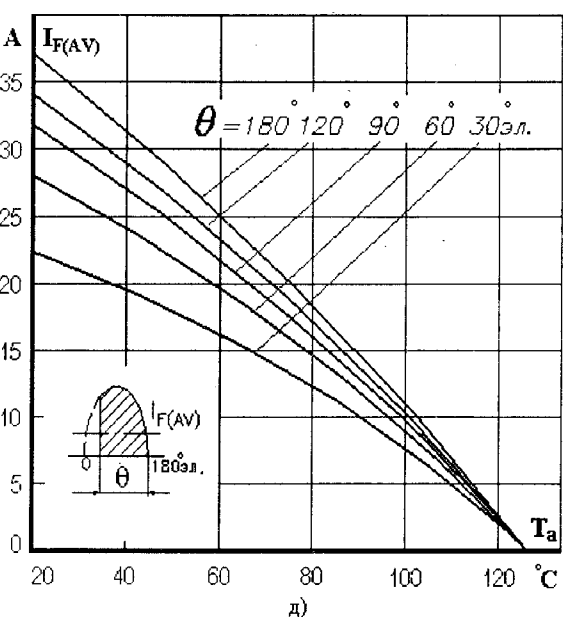
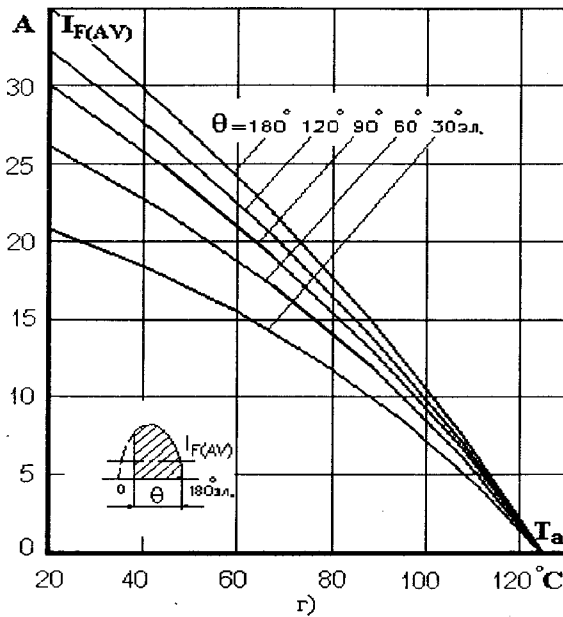
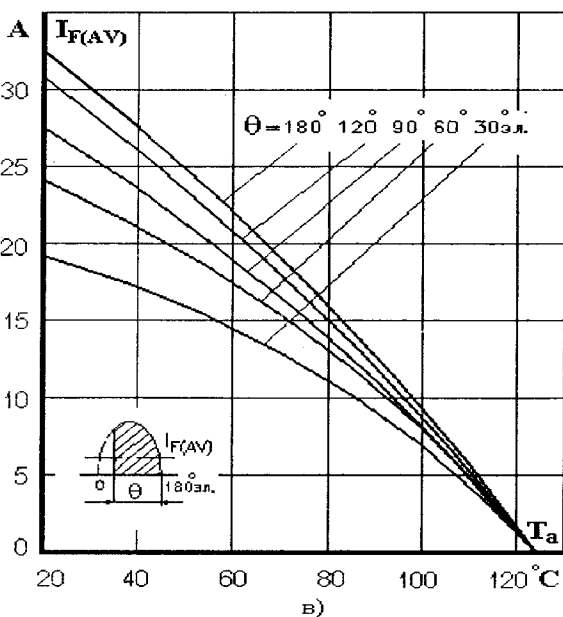
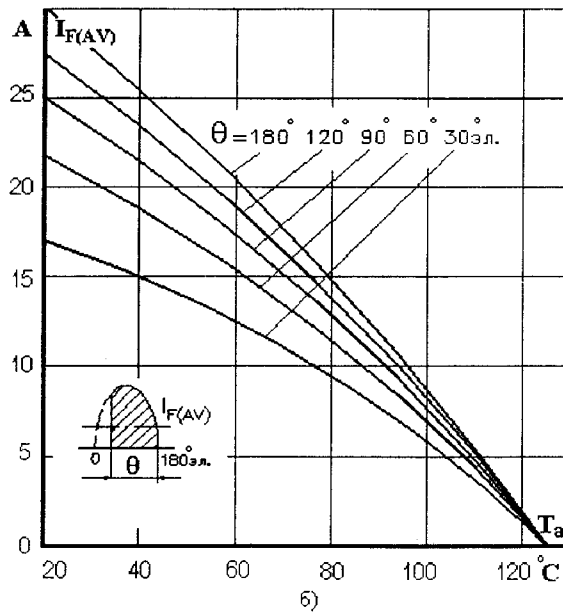
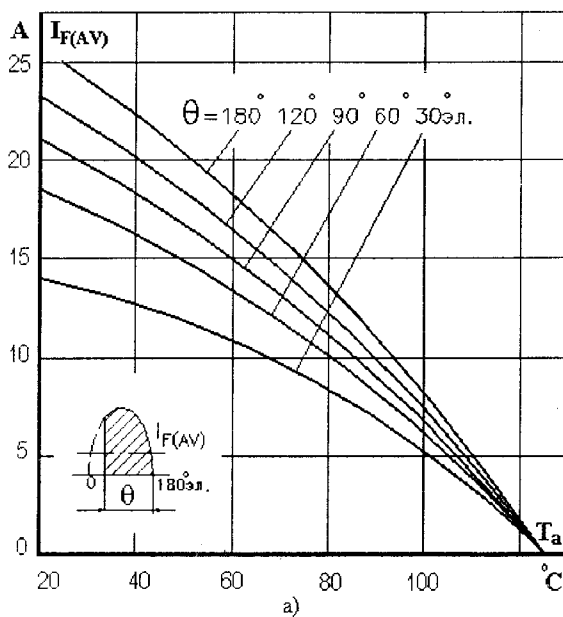


Рис. 2. 120. Зависимости допустимого среднего прямого тока синусоидальной формы $I_{F(AV)}$, частотой 50 Гц от температуры окружающей среды T_a при различных углах проводимости и естественном охлаждении на охладителе О127*:

- а) МДЧДЧ4-25; б) МДЧДЧ4-40;
- в) МДЧДЧ4-50; г) МДЧДЧ4-63;
- д) МДЧДЧ4-80.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

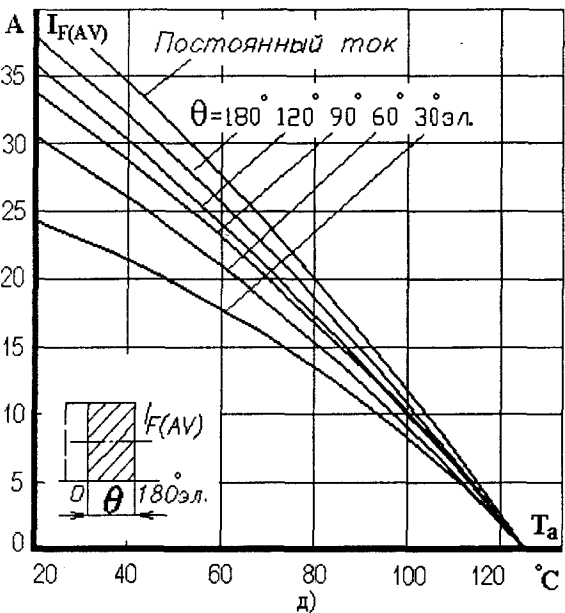
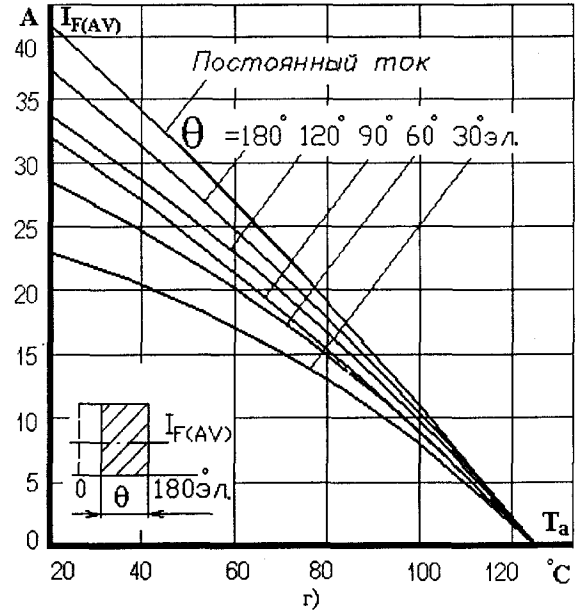
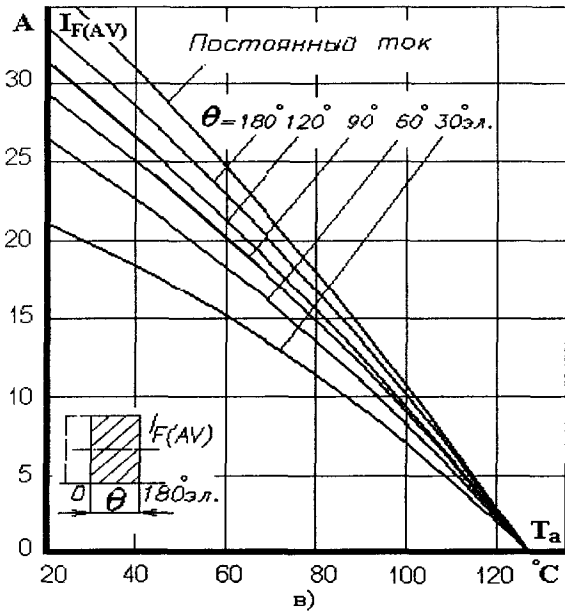
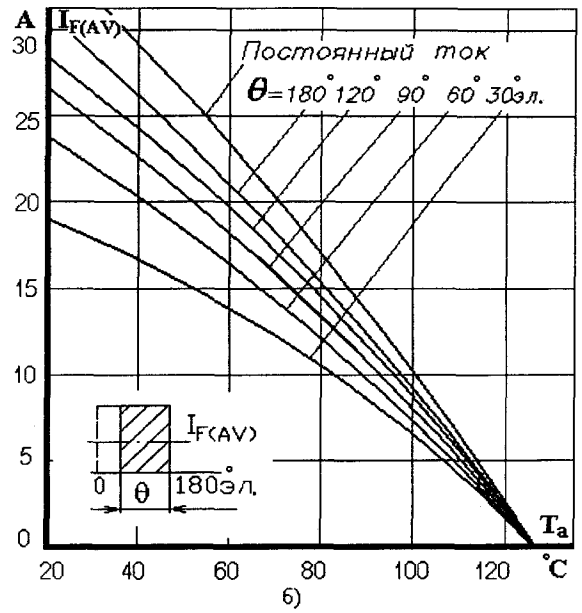
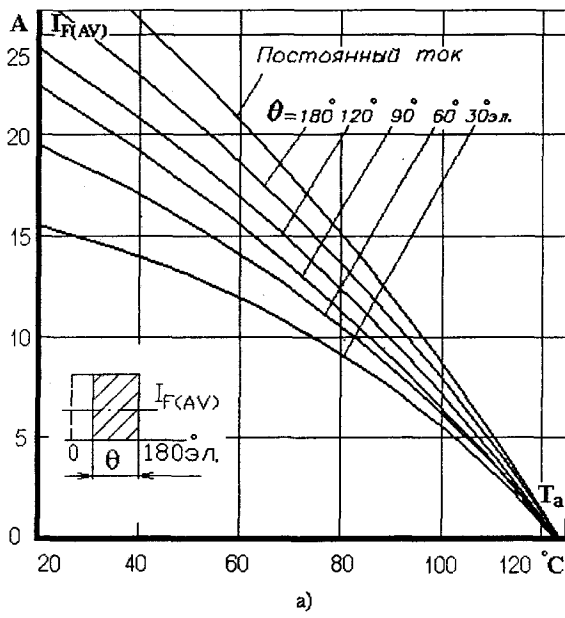


Рис. 2. 121. Зависимости допустимого среднего прямого тока прямоугольной формы $I_{F(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры окружающей среды T_a при различных углах проводимости и естественном охлаждении на охладителе О127*:

- а) МДЧДЧ4-25; б) МДЧДЧ4-40;
- в) МДЧДЧ4-50; г) МДЧДЧ4-63;
- д) МДЧДЧ4-80.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

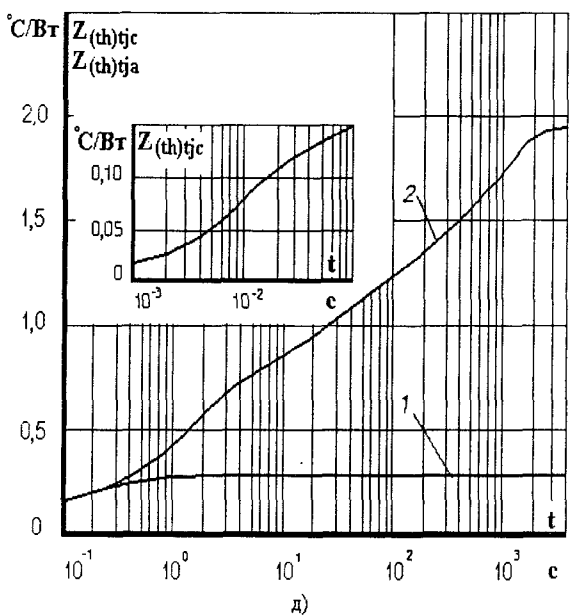
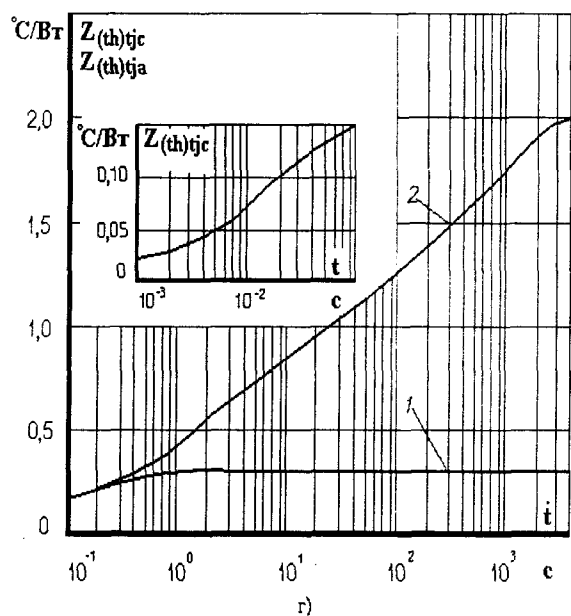
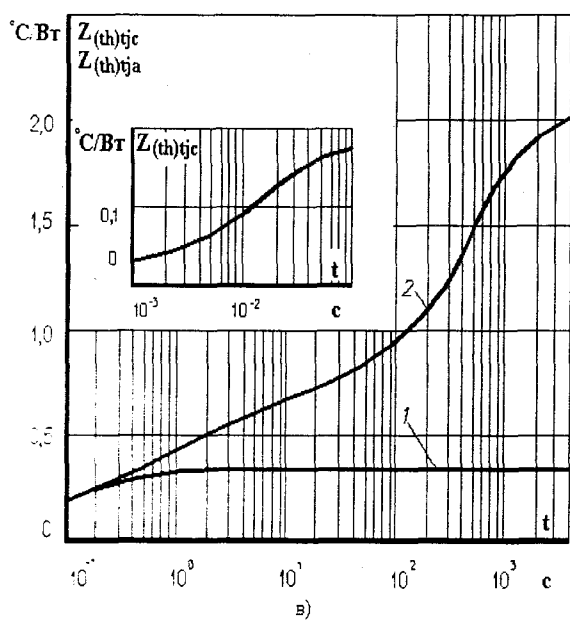
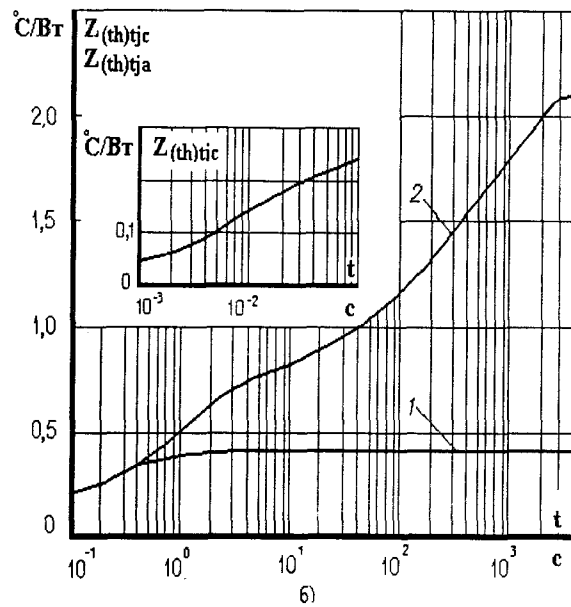
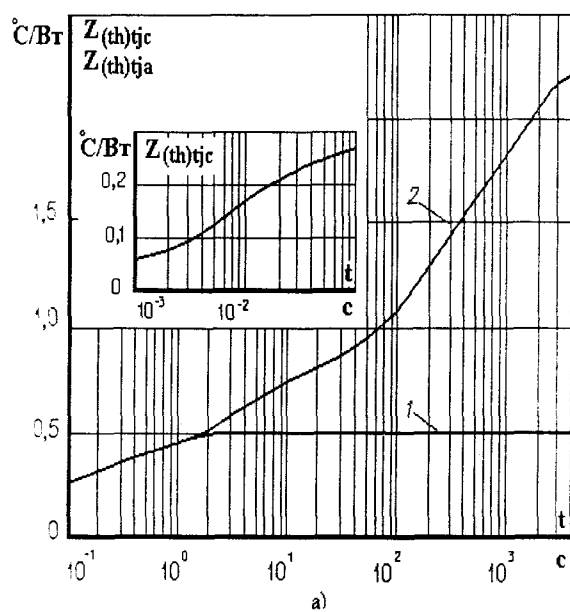


Рис. 2. 122. Зависимости переходного теплового сопротивления переход - корпус Z_{thjc} (1) и переход - среда Z_{thja} (2) от времени t для одного элемента при скачкообразном изменении мощности рассеяния на двух элементах модуля при естественном охлаждении на охладителе O127*:

- а)МДЧДЧ4-25; б)МДЧДЧ4-40;
в)МДЧДЧ4-50; г)МДЧДЧ4-63;
д)МДЧДЧ4-80.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

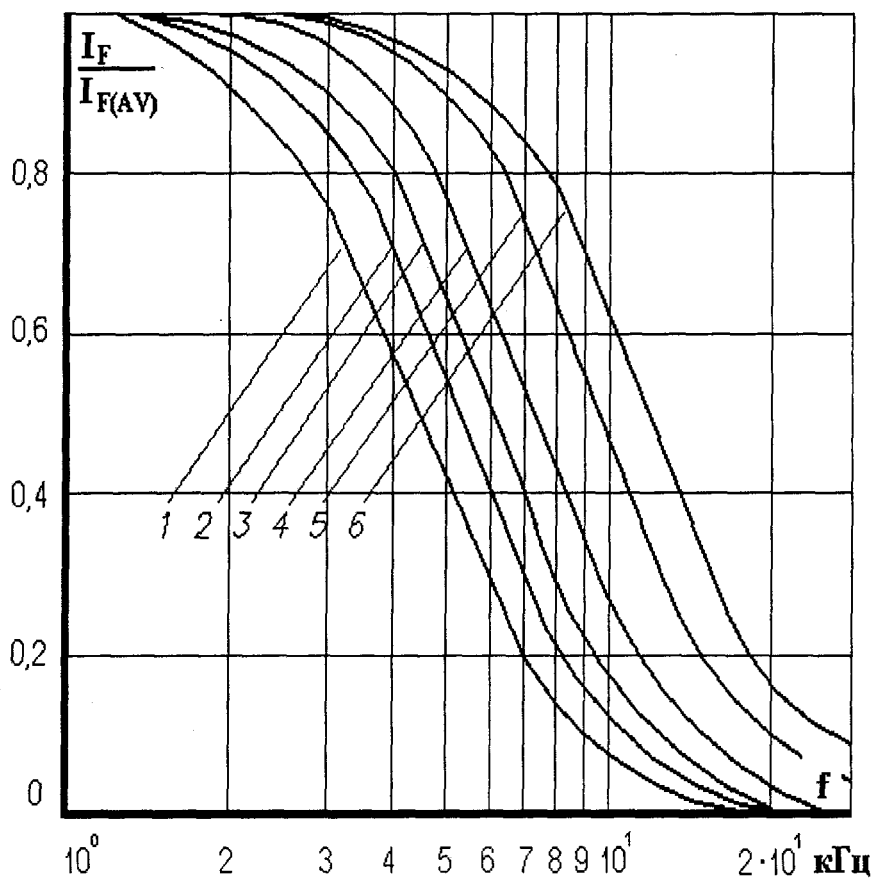


Рис. 2. 123. Типичная зависимость допустимого среднего прямого тока $I_F/I_{F(AV)}$ от частоты f при синусоидальной форме тока с углом проводимости 180° электрических для групп: А5(1), Х4(2), Т4(3), Р4(4), М4(5), К4(6).

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

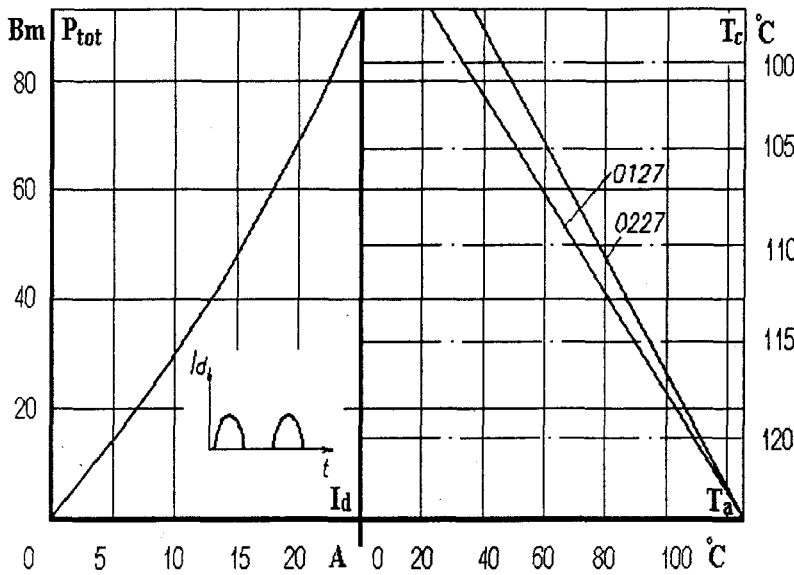


Рис. 2. 124.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДЧДЧ4 - 25 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

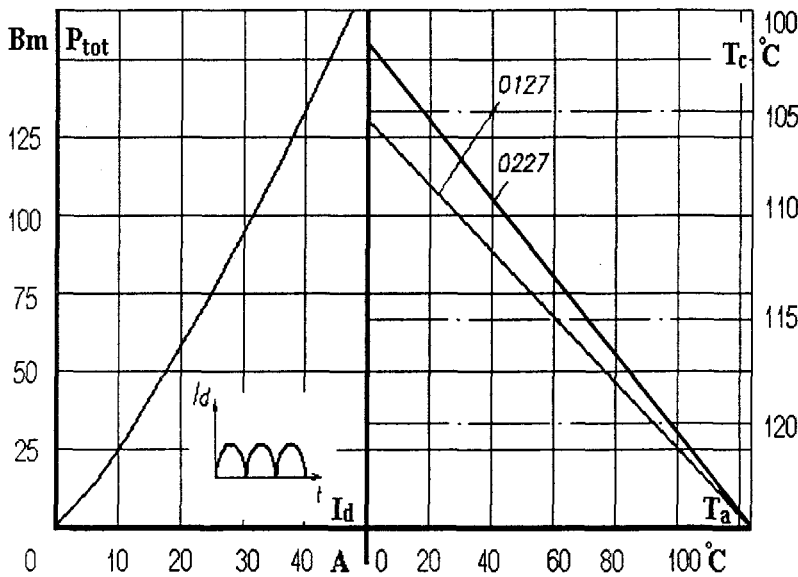


Рис. 2. 125.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДЧДЧ4 - 25 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

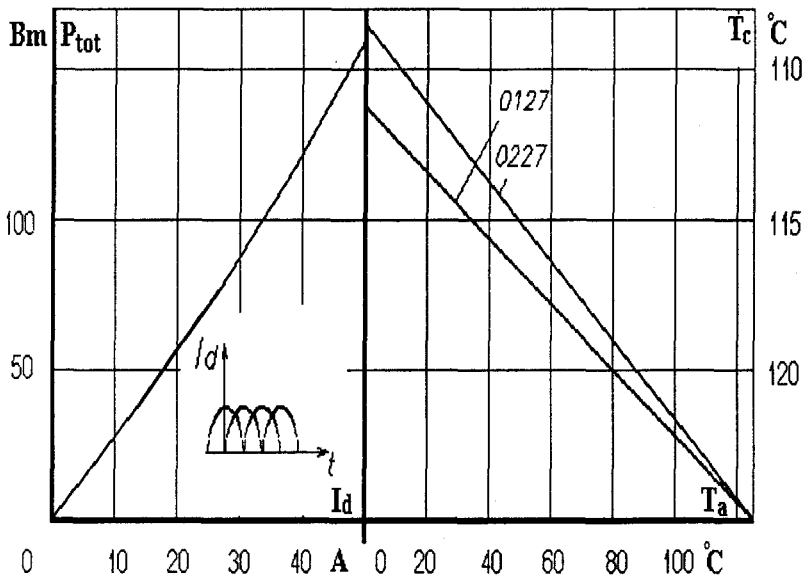


Рис. 2. 126.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДЧДЧ4 - 25 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

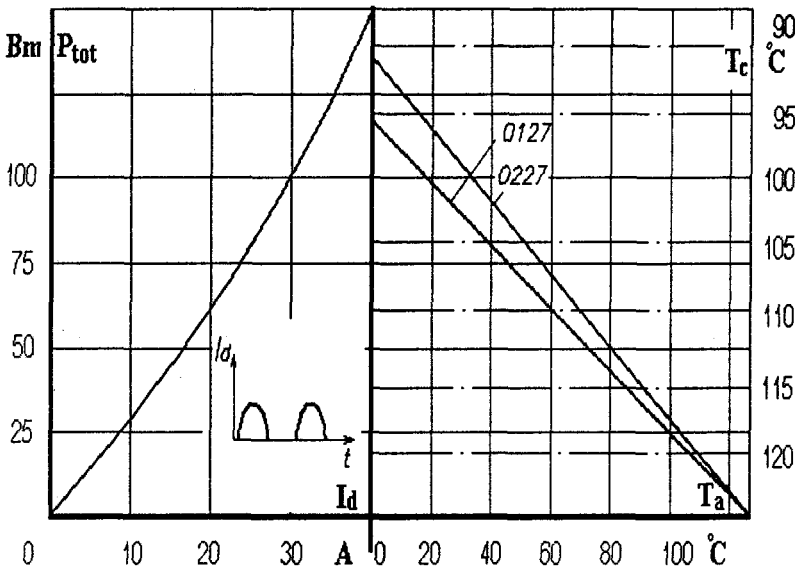


Рис. 2. 127.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДЧДЧ4 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

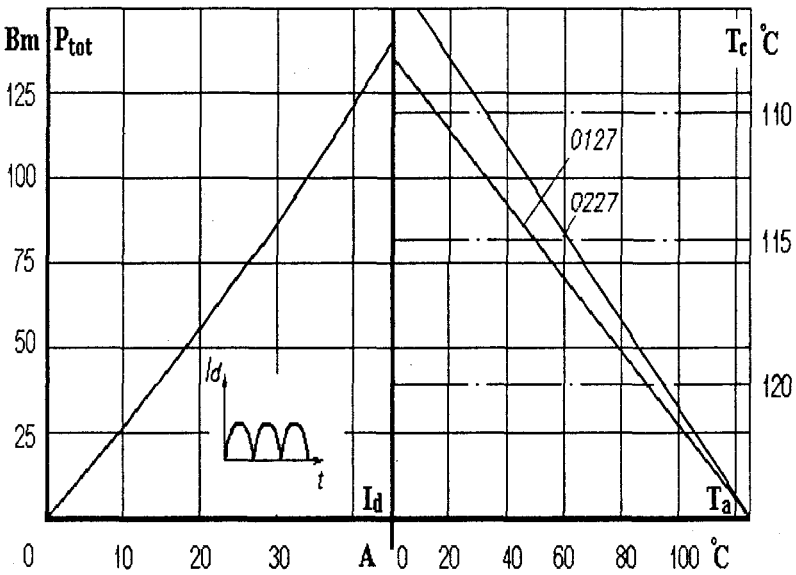


Рис. 2. 128.* Зависимость допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДЧДЧ4 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

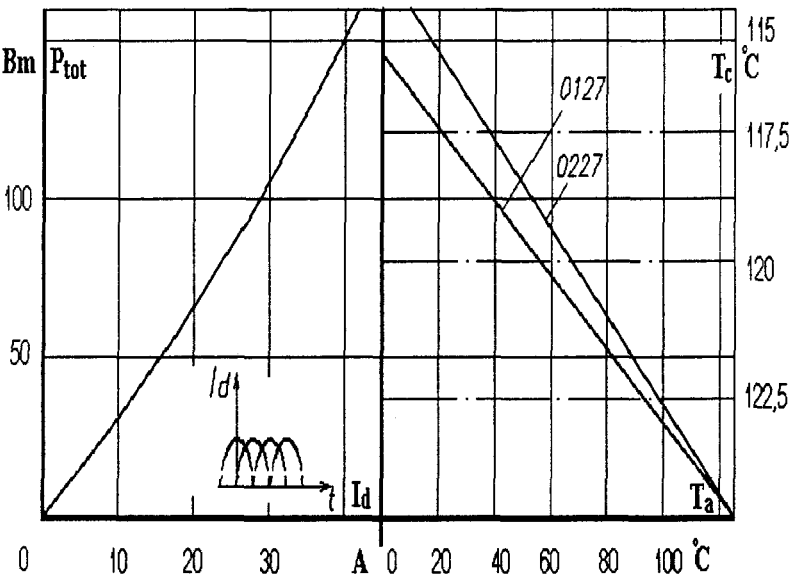


Рис. 2. 129.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДЧДЧ4 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

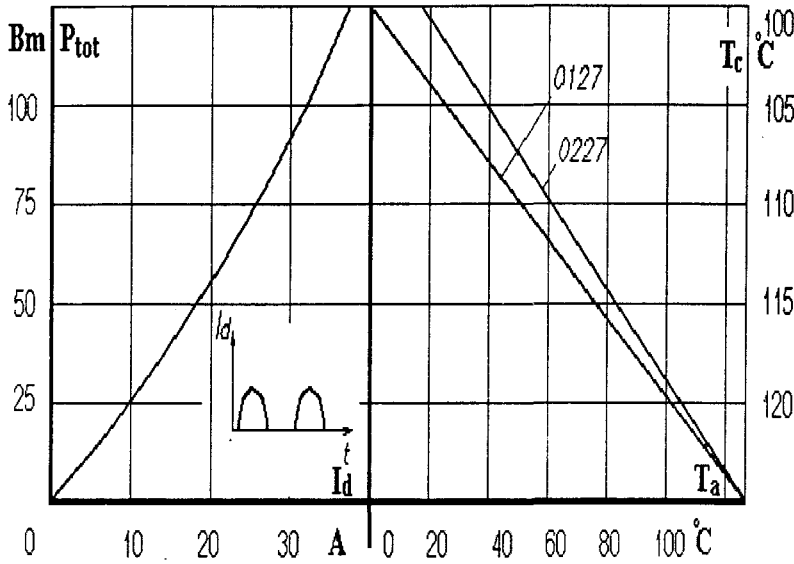


Рис. 2. 130.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДЧДЧ4 - 50 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

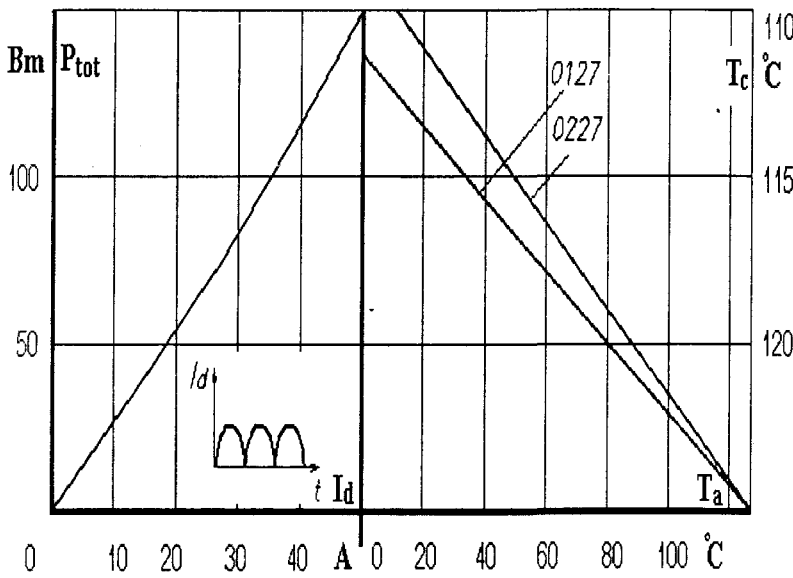


Рис. 2. 131.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДЧДЧ4 - 50 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

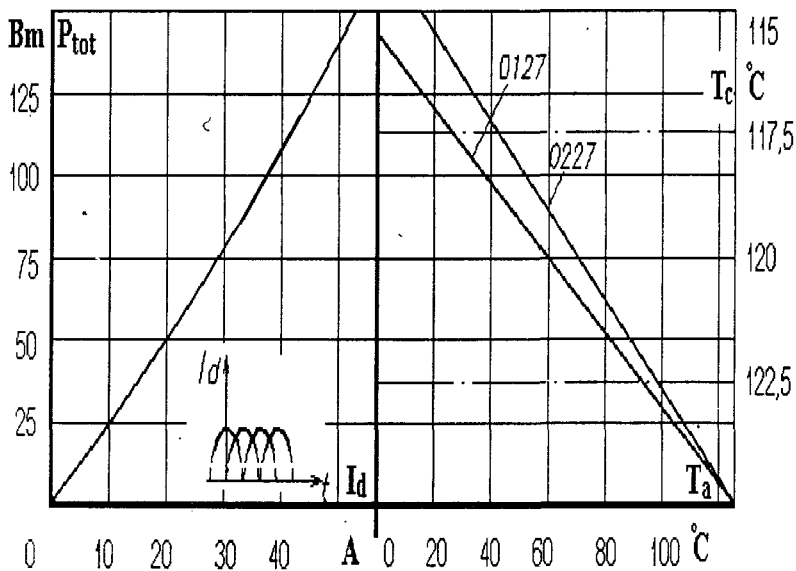


Рис. 2. 132.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДЧДЧ4 - 50 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

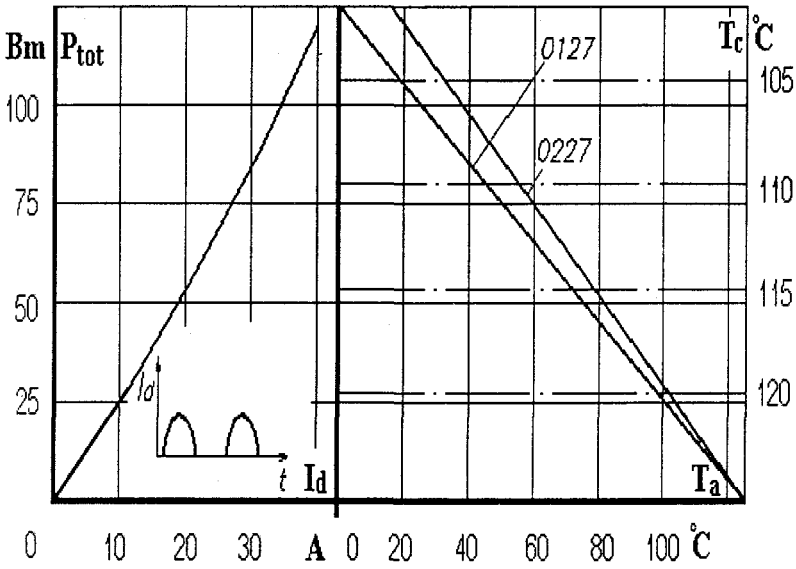


Рис. 2. 133.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДЧДЧ4 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

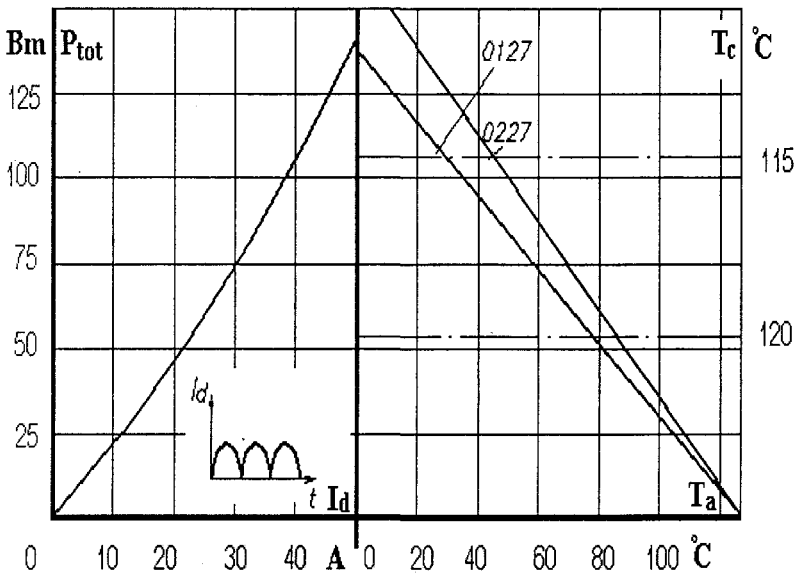


Рис. 2. 134.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДЧДЧ4 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

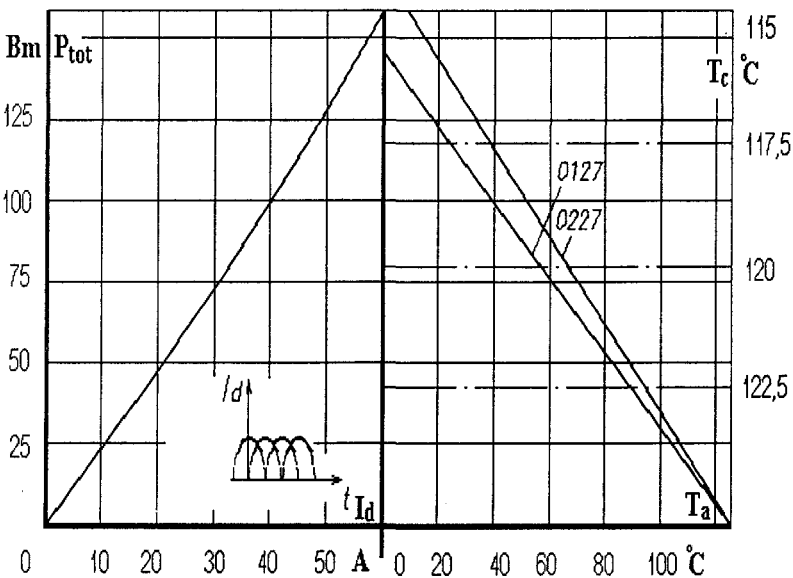


Рис. 2. 135.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДЧДЧ4 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

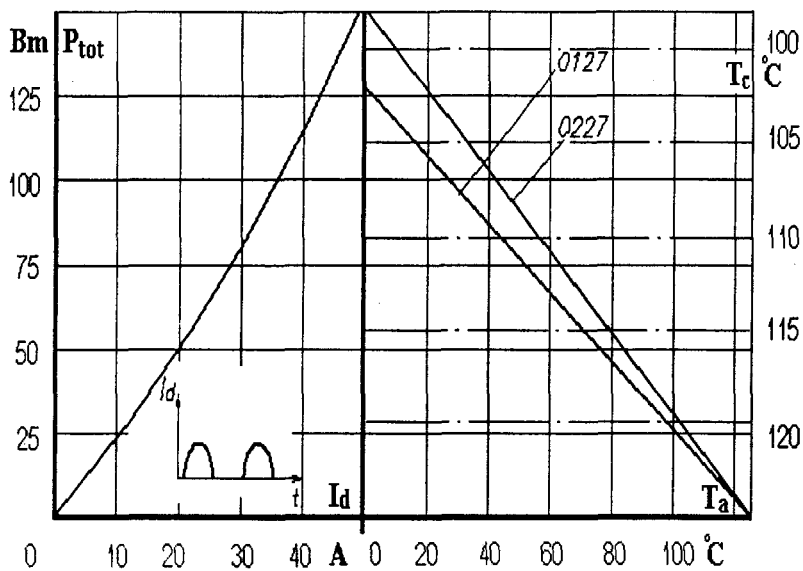


Рис. 2. 136.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДЧДЧ4 - 80 на охладителях O127 и O227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

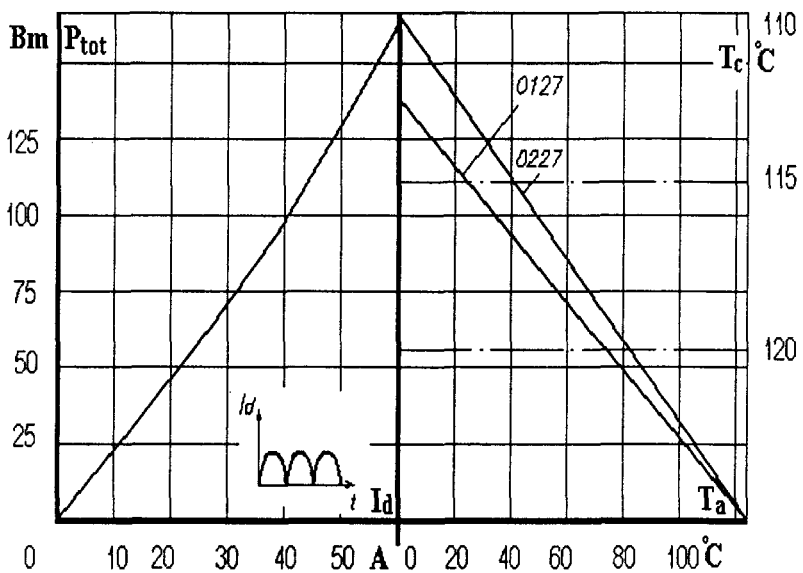


Рис. 2. 137.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДЧДЧ4 - 80 на охладителях O127 и O227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

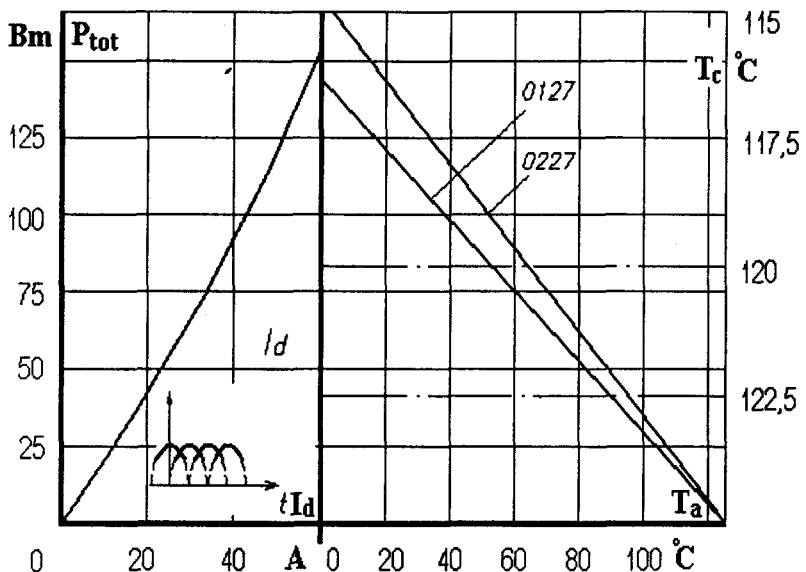


Рис. 2. 138.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДЧДЧ4 - 80 на охладителях O127 и O227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении.

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 84 каталога)

МОДУЛИ НА ЧАСТОТНЫХ ДИОДАХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные технические данные СПМ, согласно выпускаемой предприятием номенклатуры изделий, полностью охватывают возможный круг вопросов их практического использования с точки зрения разработчика и производителя. Содержат наиболее важные параметры, характеристики и аспекты обеспечения надежной и длительной эксплуатации приборов. Ориентированы на обеспечение эффективного и возможно более полного использования потенциальных возможностей данного класса полупроводниковых приборов. Используемая классификация и группировка приборов по функциональному признаку существенно облегчает поиск и использование информации. Принятая группировка параметров, зависимостей и характеристик повышает их наглядность и удобство практического использования в сочетании с эффективной системой ссылок. Информационные материалы позволяют обеспечить условия продолжительной, гарантированной эксплуатации полупроводниковых приборов, их технически грамотное использование.

Это издание является первым в выпускаемой серии по данной тематике. Планируется продолжить выпуск информационных материалов и издать технические данные о всей номенклатуре силовых полупроводниковых приборов ООО “Элемент-Преобразователь”.

Отзывы и предложения по производимой продукции, объему и качеству представленных материалов просим направлять в адрес издательства или предприятия ООО “Элемент - Преобразователь”.